






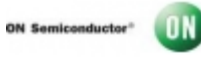


	<h2 style="color: red;">FDP036N10A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP036N10A</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3</p> <p>Datenblätter: 1.FDP036N10A.pdf 2.FDP036N10A.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 25004 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP036N10A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	25004 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	40 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 120A (Tc) 333W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	333W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	116nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7295pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP036N10A ist neu im Original, Suche FDP036N10A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP036N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP036N10A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP038AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP032N08B FSC FDP032N08B FSC</p>	 <p>FDP036N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3</p>	 <p>FDP038AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB</p>
 <p>FDP038AN06AO FSC FDP038AN06AO FSC</p>	 <p>FDP038AN06A0-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO220-3</p>	 <p>FDP032N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP032N08-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 75V 120A TO220</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FDP020N06B	↔ FDP023N08B	⇒ FDP025N06	D FDP025N06	↔ FDP027N08B
⊣ FDP027N08B	⊛ FDP030N06	D FDP030N06	⇒ FDP030N06B_F102	↔ FDP032N08
⊛ FDP032N08	⊣ FDP032N08B	⊛ FDP036N10A	↔ FDP038AN06A0	↔ FDP038AN06A0
D FDP038AN06AO	⊛ FDP039N08B	⊣ FDP040N06	⊛ FDP040N06	↔ FDP045N10A
⇒ FDP045N10A	↔ FDP047AN08	⊛ FDP047AN08A0	⊣ FDP047AN08A0	↔ FDP047AN08A0
↔ FDP047N08	⇒ FDP047N08	D FDP047N08AO	⊛ FDP047N10	⊣ FDP047N10
⊛ FDP050AN06A0	D FDP050AN06A0	⇒ FDP050AN06A0	↔ FDP053N08B	↔ FDP053N08B_F102
⊣ FDP054N10	⊛ FDP054N10	↔ FDP060AN08A0	⇒ FDP060AN08A0	↔ FDP060AN08A0
⊛ FDP060N08A0	⊣ FDP060N08AO	⊛ FDP068AN08A0	D FDP070AN06A0	↔ FDP070AN06A0
↔ FDP070AN06AO	⊛ FDP075N15A	⊣ FDP075N15A	⊛ FDP083N15A	↔ FDP083N15A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited